News Release

2026年11月11日

各　位

ＪＸ金属株式会社

台湾における先端パッケージ向けガラス基板のプロセス開発共創に当社グループ材料を活用

ＪＸ金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、台湾工業技術研究院（ITRI）が設立したアライアンス「Hi-CHIP（Heterogeneous Integration and Chiplet System Package Alliance）」が推進する次世代半導体パッケージ技術の開発プロジェクトにおいて、当社の半導体用スパッタリングターゲットおよび当社グループのタツタ電線株式会社（社長：飯田 一彦、以下「タツタ電線」）の導電性ペーストが活用され、その取組成果がHi-CHIPにより、2026年10月21日、台湾で開催された電子実装・半導体パッケージ分野の国際会議「IMPACT 2026」で発表されたことをお知らせいたします。

Hi-CHIPは、台湾工業技術研究院（ITRI）が中心となって設立したアライアンスで、台湾半導体関連企業（Intel Corporation,'ASML Holding N.V.,'Applied Materials, Inc.の台湾拠点を含む）のみならず、海外の半導体・半導体材料・装置・実装関連企業も参画する国際的な連携基盤です。各社の知見を結集し、異種集積やチップレットに対応した先端パッケージの設計、試作、評価、量産化に向けた技術開発を進めています。AI半導体などのさらなる高性能化を支える次世代パッケージ技術の実用化を目指す取り組みとして注目を集めています。

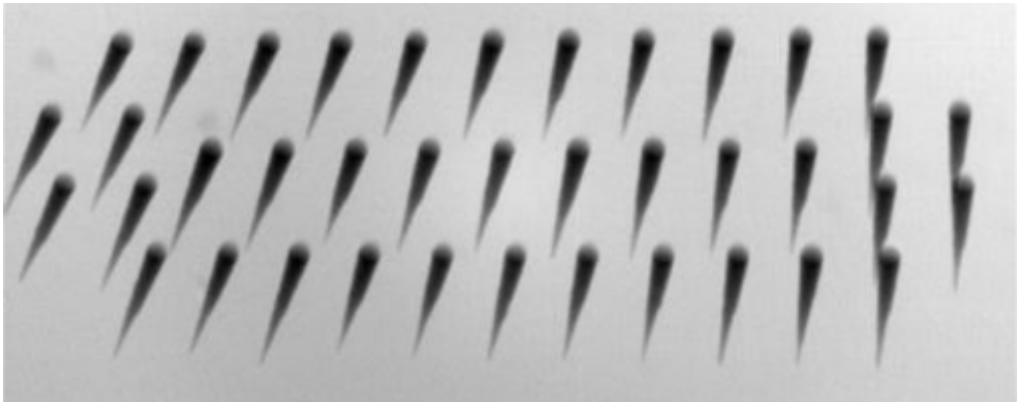
当社は、Hi-CHIPが推進する、ガラスインターポーザーやガラスコア基板を用いた次世代半導体パッケージ技術を目指すプロジェクトに参画しています。この度、ガラスインターポーザーの微細配線形成に当社のスパッタリングターゲットが使用され、配線形成の基礎となるシード層が良好に形成されたことを発表しました。また、ガラスコア基板に形成されたTGV(Through Glass Via：ガラス貫通電極)への充填工程でタツタ電線の導電性ペーストが使用され、ビア充填および導通形成が実施されました。

ガラスインターポーザーとガラスコア基板は、いずれもガラスの高い平坦性や寸法安定性により、大面積化しても反りや変形を抑えやすく、微細な配線を高精度に形成できるといった特長があります。このため、複数の半導体チップを高密度に実装する次世代半導体パッケージの大型化・高密度化に適した基板材料として期待されています。今後、ガラスインターポーザーやガラスコア基板の実用化が進むことで、微細配線形成に用いられるスパッタリングターゲットや、貫通電極の充填に用いられる導電性ペーストの重要性も一層高まると考えられます。当社グループは、これらの材料を通じて、次世代半導体パッケージ技術の発展に貢献していきます。

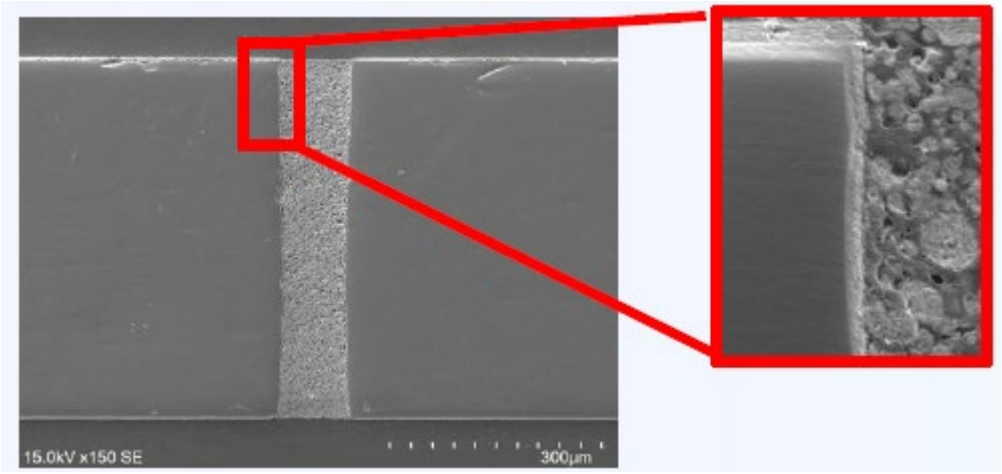
今後も当社グループは、「2040年ＪＸ金属グループ長期ビジョン」のもと、半導体をはじめとする先端技術の進化を支える高機能材料の開発・提供を通じて、社会の発展と革新に貢献してまいります。

以　上

ＪＸ金属株式会社 コーポレートコミュニケーション部 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号オークラプレステージタワー



IMPACT 2026 でのプロジェクト成果発表（当社スパッタリングターゲットを活用）
ガラスインターポーザーに当社のスパッタリングターゲットを使用してシード層を形成した様子。



ガラスコア基板に形成された TGV への充填工程で導電性ペーストが使用された。



IMPACT 2026 でのプロジェクト成果発表（タツタ電線の導電性ペーストを活用）